

(2,000F3)

特 📓 順

48 12 5<sub>8</sub>

豪 明 者

3/4/9/20/20/24/7507 東京都小平市上水本町 1450 香油

特許出願人

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号.

5 . 8 GIO 株式会社 日 立 製 作 所

自 轉 由 曾 中国

代 斑 人

財 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号株式会社 日 立 製 作 所 内

電影東京 270-2111(大代表)

(7887) 弁理士 再 田 末/6

① 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 50-87278

43公開日 昭50.(1975) 7.14

②特願昭 48-135409

②出願日 昭48 (1973)ノム、 5

審査請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号 7216 57

ᡂ日本分類 99(め)CI (1) Int.Cl<sup>2</sup>.

Holl 21/28

Holl 21/44



#### 明 編 書

発明の名称 半導体ペレットのパンプ電極形成法 等許額点の機関

半導体ペレットの電極パッド上に軟質金属から なる金属機器の一端を圧落子を用いて圧着後、圧 着部上部を切断してペンプ電極を形成することを 特徴とする半導体ペレットのパンプ電極形成法。

# 発明の評解な説明

本発明は半導体製量の製造について、ワイヤレ ス方式により半導体ペレットの電視とリードフレ ー4又は配替基準とを装置する半導体ペレット上 のパンプ電信形成法に関する。

半導体ペレットの電極ペッドと外部に導出する リードとの間の接触は、主としてワイヤボンディ ング方式が採用されている。

しかし最近では、かかるワイヤボンディング方 文では、工数が大なることから、ワイヤレスポン ディング方式に移りつつある。 すなわち、半導体 ペレットの平らな電響パッドを美出する形状のパ ンプ電板形成し、リードフレームまたは配離者 板化フェースよウン(面対向 )してペレットを取 付ける方法である。

上記パンプ電電を形成する一方決として、接層 パンプ決があり、これは電磁パッドに異なる金属 をメッキ又は無常等により表み重ねて形成する方 法であるため、製造工数が多くかかり、したがつ て高値であるという問題があり、また、突出する パンプ電電の高さはせいせい10m どまりで、袋 袋時突出金が少ないことから、リードとペレット の装蔵以外の部分との間で展帯するかそれがあつ た。

他の方法として、予め例からなる会談ボールを 形成しておいて、とのボールをロウ材を介して電 セペッドに取付けてペンプ電極を形成するソルダ ーボールによるものも考えられていた。この場合 にはペンプ電極の突出量は大きいが、直径100月 機匠の小さなボールを均一を大き点に形成することは極めて困難であり、各ペンプ電極を均一な高 さにすることは困難である。また、ボール自体被 い金銭で形成されていたから、接続時均一を高さ

特閉 第50— 87278(2)

に修正されまかつた。そのために、リードフレーム又は配額高板との接続不良が生じ借額度が低くかつた。それにこの方法では、予めポールを形成し、ロウ材を介してパンプ電電を形成することから、パンプ電電形成が比較的複雑であり、高値になる欠点があつた。

そとで、奥出量が大きく、しかも簡単に形成で きるパンプ電極形成方法コよびリードフレーム又 は配線当板との接続が良好になるパンプ電電形成 法を考えた。

・したがつて、本発明の目的は、パンプ電極の失 出量を大きくし、かつそれを簡単に形成できるよ りにすることにある。本発明の傷の目的は、パン プ電電を装飾時均一な高さにして、リードフレー ム又は配着値板との接続を良好にし、接続部の信 額度を向上させることにある。

上記目的を達成するための本発明の基本的支持 成社、半導体ペレットの電響パッド上に軟質金属 からなる金属組装の一端を圧着子を用いて圧着後、 圧着部上部を切断してパップ電響を形成すること を特徴とするものである。 以下図面を参照しながら、本発明の一実施例を

以下図面を参照しながら、本発明の一実施例を 具体的に観明する。

第1 個は半導体ペレクトのペンプ電低形成法を 工程順に示したものである。

(4) 素子能域が形成され、その領域の外側には電 極端出するためのアルミニウムからなる電極パッ ドミが形成された半導体素子(後の半導体ペレッ トとなる部分)1が多数個配置された半導体ウェ ーペムを用電する。

パンプ電極を形成しようとする上配電極ペッド の過程は180~140#平方である。

- (1) 次にネイルヘッドワイヤボンディング製量を 用意し、導出された金額ワイヤミを水素炎もで切 断しキャピラリミの先端に金ポールをを作る。こ の金ポールの電磁は約180mがである。
- (c) パンプ電極まれ金ポール 6をポンディングする。一種の熱圧着によりパンプ電磁まれ金ポール 6 が姿貌される。
- (A) ポンディングした後、ヤヤビララ 5 0 みを上

ける。

(e) ワイヤるをクランブし、キャピラリ 5 をさら ド上げてワイヤ 5 を切断する。ワイヤ 5 は根本す をわち、ボール 6 のその上部で切断され、そして、 電低ペッド 8 上には突出量の大きなパンプ電響す が形成される。

上記パンプ電極の美出量は約180%になる。
(d) ワイヤ 3 先端を水素炎 4 で加熱し、キャビラリ 5 先端に再び金が一ル 6 を作る。そして、上記工程をくり返して各電極ペッド 8 にそれぞれ突出するパンプ電極 7 を形成する。その後、各半導体ペレット 1 ごとに分離する 2 毎に沿つてダイヤモンドカッタで切断し、各電磁ペッド 8 にそれぞれ突出パンプ電板 7 を形成した半導体ペレットを得る。

このよう化して形成したパンプ電電ッを有する 半導体ペレットをリードフレーム 8 にペレットポ ンディングすると言には、半導体ペレットのパン ブ電電平面を下面にしてリードフレーム 8 に接触 させ、熱圧着で接続する。

以上完施何で述べたような本発明によれば、(1) ネイルヘッドワイヤボンデイング製量 を使用する から、ワイヤの太さに応じた大きさのポールを形 送するととができる。 普通用いられる金譜ワイヤ の宣伝は25~50# であり、直径100~180#年 ポールを簡単に形成することができる。 したかつ て、電極パッドに金ポールをポンディングすると とにより、突出量の大なるパンプ電極を形成する ことができる。また、ネイルヘッドワイヤポンデ インダにより、単にワイヤポンティングし、ポン ディング上部を切断するだけでパンプ電極ができ るので、簡単に形成することができる。(2)軟かい 金属である金( Au ) でパンプ電極を形成するた め、突出量の多少大小高低があつたとしてもリー ドフレーム又は記憶蓄板との接続時、ペンプ電艦 は風性変形して均一な品されなるから、リードフ レーム又は配舗蓄板との姿貌は良好になり、姿貌 部の信頼度を向上させるととができる。

第3回、第4回は本発明の他の実施例である。 第3回はオイルへタドワイヤポンディング要量

特開 昭50- 87278(3)

を用いた他の実施例である。

(4) ポンディング装置によりワイヤるをポンデイ ングした後、キャピラリを上げる。次にワイヤを 引つばることなく、水栄夫によつてその上を切断 しポンディング部(圧着部)上部に全ポールをも 形成し、金ポールのを有するパンプ電磁りを形成

(1) このままでは、ペンプ電框では機械的限度が 暑いので、金ポール8が一部(約半分)舞出する ように耐熱性智能のにより半導体ペンツトン表面 を覆い、半導体ペレフトン表面が保護肌に振りむ れたパンプ電弧?を有する半導体ペレフトを得る。 なか、上記計熱性脊癬保護質の単さは3=程度 である。ペンツトポンディングは貧配すると同様 だして行ない良好に萎続できる。

第6回は超音波ワイヤポンデイングにより、パ ンプ電框ツを形成するようにしたものである。と の場合にもペンプ電盔マを簡単に形成することが・ てまる。

たか、本品明に適用できるワイヤは金菓ワイヤ

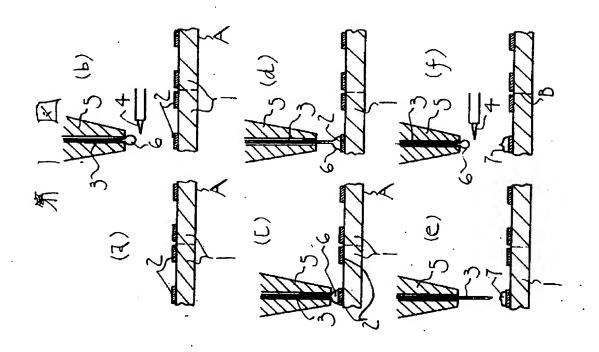
以外アルミニウムワイヤ、銀ワイヤ等の軟質企具 ワイヤが使える。

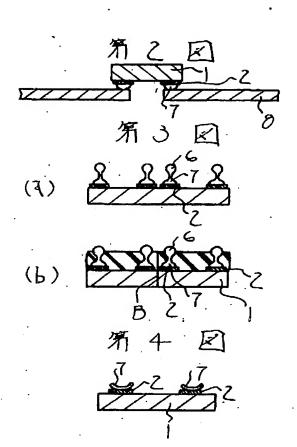
## 図面の領単な説明

第1回は本発明の一実施例を工程膜に示したも ので、何~切は各工程の断面図、第8回は本発明 化より形成した半導体ペレットをリードフレーム **に取付けた状態を示す断価図、店3回、第4回は** 本発男の他の実施例の新田園である。

1・・半導体素子(半導体ペンツト)、ま・・ 電極ペッド、5・・金銭ワイヤ、6・・水紫炎、 5・・キャピラリ、5・・金ポール、7・・パン ブ電極、8・・リードフレーム、9・・・耐熱性模 脂、A・・半導体ウエーハ、B・・各半導体ペレ ットととに分離する値。

代理人 弁理士 蒂 田





国和国	73	<b>の</b>		3			
(1)	93					•	12
(2)	M						1 23
(2)	#		Œ		Et		12
(4)	42	27		12	*		120

### 前記以外の発明者、特許山原人または代理人

発	剪	者 コダイランジョウスイボンチョウ
á	m m	東京都小平市上水本町 1450 香地
•		你式会社 日立製作所食献工場內 年 至 2 2 2
£.	1 2 7	谷本道夫